

A101

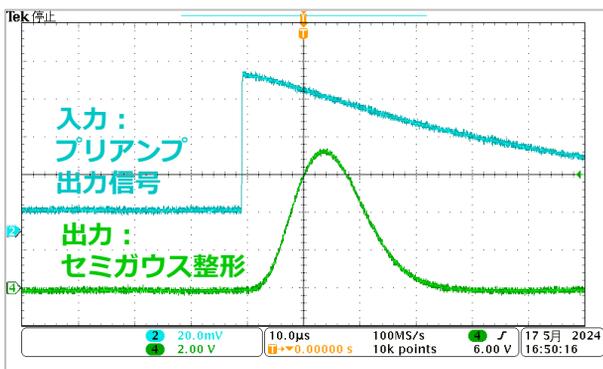
A101はNIM1幅のスペクトロスコピアンプです。波形整形はアクティブフィルタ方式を採用し、理想のガウス整形に近づけております。最新の低雑音FETを利用したディスクリート増幅回路を採用しており、入力雑音特性を5 μ V以下に抑えております。アクティブゲート方式のベースラインレストアラも搭載しているため、高計数率などの測定にもご利用できます。A101は特にHPGe半導体検出器を用いた測定において、優れた分解能と直線性を実現することが可能です。

主な特徴

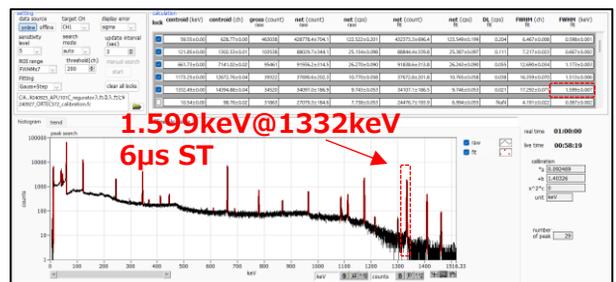
ゲイン	1~1500倍
波形整形	セミガウス整形 ピーキングタイム2.2 τ , パルス幅6 τ
雑音特性	入力換算5 μ V以下 2 μ s時 ゲイン \geq 100
積分非直線性	< \pm 0.05% 2 μ s時
ベースラインレストアラ	アクティブゲート方式オートスレッシュホルド
高計数率特性	ピークの広がり最大15% 2 μ s, 入力計数率50kcps時

仕様

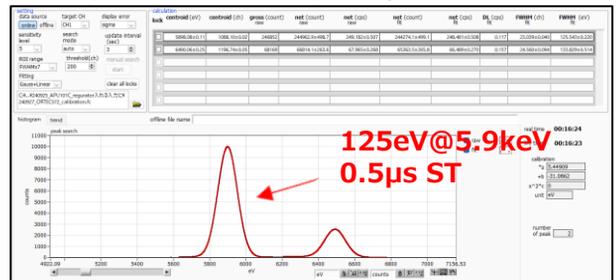
入力極性	POS(正) / NEG(負)
アッテネータ	\times 0.1/ \times 1.0 内部基板のジャンパーにより切替
COARSE GAIN	\times 20/ \times 50/ \times 100/ \times 200/ \times 500/ \times 1K
FINE GAIN	\times 0.5~ \times 1.5
PZ ADJ	ポールゼロ調整, 40 μ s \sim ∞
DC	\pm 40mV
SHAPING TIME	0.5/ 1/ 2/ 3/ 6/ 10 μ s
入力特性	レンジ: \pm 1.5 V, 入力インピーダンス: 1 k Ω
出力特性	正極ユニポーラ 0-10V, 駆動電流 \pm 100mA
BUSY OUT	TTL出力
プリアンプ電源	D-Sub9 \pm 12V, \pm 24V (NIM規格準拠) 内蔵
消費電力	+12V (160mA) +24V (40mA), -24V (40mA)
寸法・重量	NIM1幅 34(W) x 221(H) x 249(D) mm, 約975g



HPGe半導体検出器



SDD (シリコンドリフト検出器)



※写真はイメージです。
※記載内容は予告なく変更することがあります。

